



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

表面富硅多孔碳化硅陶瓷表面分子筛涂层材料的制备方法

文献类型: 专利

作者 张劲松, 矫义来, 杨振明, 田冲 and 曹小明

发表日期 2010-06-09

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明涉及一种表面富硅多孔碳化硅陶瓷表面分子筛涂层材料的制备方法。采用表面富硅多孔碳化硅陶瓷作为载体,使用硅块、石英、硅铝原子比可调的硅铝复合氧化物烧结粉体等固体原料作为硅源或硅铝源,原位水热合成。由于多孔碳化硅陶瓷表面硅层的存在,使分子筛晶体优先在多孔碳化硅陶瓷表面形核,固体硅源或硅铝源的使用使供给晶核长大的硅源或硅铝源释放速度可控。这样制备的分子筛涂层在碳化硅陶瓷载体表面负载均匀,分子筛与多孔碳化硅陶瓷所组成的复合材料具有独特的微孔/大孔结构;分子筛和多孔碳化硅陶瓷之间实现了化学结合,具有高的界面结合强度。该方法工艺简单、操作方便、无需复杂设备,制造成本低,更适合工业化、大批量生产。

公开日期 2010-06-09

语种 中文

专利申请号 CN101723709A

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/65828>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 张劲松, 矫义来, 杨振明, 田冲 and 曹小明. 表面富硅多孔碳化硅陶瓷表面分子筛涂层材料的制备方法. 2010-06-09. **GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
122	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

